

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成27年2月19日(2015.2.19)

【公開番号】特開2013-168620(P2013-168620A)  
 【公開日】平成25年8月29日(2013.8.29)  
 【年通号数】公開・登録公報2013-046  
 【出願番号】特願2012-32635(P2012-32635)  
 【国際特許分類】

H 0 1 S 5/16 (2006.01)

【F I】

H 0 1 S 5/16

【手続補正書】

【提出日】平成26年12月17日(2014.12.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

まず、図1に示すように、Siをドーブしたn型GaAs基板1上に順に、 $2.8\mu\text{m}$ 厚の $\text{Al}_{0.48}\text{Ga}_{0.52}\text{As}$ からなるn型クラッド層2、 $\text{Al}_{0.335}\text{Ga}_{0.665}\text{As}$ ( $10\text{nm}$ ) /  $\text{Al}_{0.112}\text{Ga}_{0.888}\text{As}$ ( $8.4\text{nm}$ ) /  $\text{Al}_{0.335}\text{Ga}_{0.665}\text{As}$ ( $8.4\text{nm}$ ) /  $\text{Al}_{0.112}\text{Ga}_{0.888}\text{As}$ ( $8.4\text{nm}$ ) /  $\text{Al}_{0.335}\text{Ga}_{0.665}\text{As}$ ( $10\text{nm}$ )からなる量子井戸構造の活性層3、 $0.165\mu\text{m}$ 厚の $\text{Al}_{0.48}\text{Ga}_{0.52}\text{As}$ からなるp型クラッド層4、及び $20\text{nm}$ 厚のGaAsからなるp型コンタクト層5をMOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)により形成する。